



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ФГБОУ ВО «ИГУ»

Кафедра общей и экспериментальной физики

УТВЕРЖДАЮ
Декан физического факультета
Н.М. Буднев
«20» марта 2026 г.



Рабочая программа дисциплины

Наименование дисциплины **Б1.В.06 Технологии материалов электронной техники**

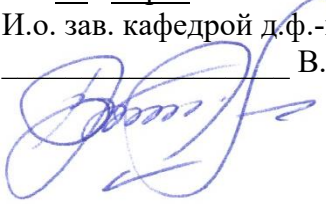
Направление подготовки **11.03.04 Электроника и наноэлектроника**

Направленность (профиль) подготовки **Электроника и наноэлектроника**

Квалификация выпускника **бакалавр**

Форма обучения **очная**

Согласовано с УМК
физического факультета
Протокол № 53 от «17» марта 2026 г.
Председатель д.ф.-м.н., профессор
 Н.М. Буднев

Рекомендовано кафедрой:
Протокол № 7
от «05» марта 2026 г.
И.о. зав. кафедрой д.ф.-м.н.
 В.П. Дресвянский

Иркутск 2026 г.

Содержание

	стр.
1. Цели и задачи дисциплины (модуля)	3
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП.	3
3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)	3
4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы	4
5. Содержание дисциплины (модуля)	5
5.1 Содержание разделов и тем дисциплины (модуля)	5
5.2 Разделы дисциплины (модуля) и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами (модулями)	7
5.3 Разделы и темы дисциплин (модулей) и виды занятий	8
6. Перечень семинарских, практических занятий и лабораторных работ.	11
7. Примерная тематика курсовых работ (проектов) (при наличии)	13
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)	13
:	
а) основная литература;	13
б) дополнительная литература;	13
в) программное обеспечение;	14
г) базы данных, поисково-справочные и информационные систем	14
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины	
10. Оценочные средства. (ОС).	14
	15

1. Цели и задачи дисциплины:

Целью курса является ознакомление студентов с основами и особенностью технологии изготовления изделий электронной техники, уровнем и перспективами развития важнейших направлений современной микроэлектронной технологии

Задачи курса:

показать, что при изготовлении полупроводниковых приборов и интегральных микросхем различных типов применяют набор универсальных технологических операций, выполняемых в определённой последовательности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина “Технология материалов электронной техники” является дисциплиной профессионального цикла и относится к вариативной части.

Курс базируется на курсах “Физика полупроводников”, “Физическая химия материалов”, “Методы исследования материалов и структур электроники”

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля):

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций: **Профессиональные компетенции (ПК):** ПК-8: способность выполнять работы по технологической подготовке производства материалов и изделий электронной техники,

В результате освоения дисциплины “Технология материалов электронной техники” обучающийся должен:

Индекс компетенции	Образовательный результат
ПК-8 способностью выполнять работы по технологической подготовке производства материалов и изделий электронной техники	Знать как выполнять работы по технологической подготовке производства материалов и изделий электронной техники. Уметь выполнять работы по технологической подготовке производства материалов и изделий электронной техники. Владеть работами по технологической подготовке производства материалов и изделий электронной техники.

4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы (разделяется по формам обучения)

Вид учебной работы	Всего часов
Аудиторные занятия (всего)	52
В том числе:	-
Лекции	22
Практические занятия (ПЗ)	22
Контроль самостоятельной работы	1.1
Самостоятельная работа (всего)	24
В том числе:	-
Реферат (при наличии)	20
<i>Другие виды самостоятельной работы</i>	4
<i>Контрольная работа</i>	4
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)	зачет
Общая трудоемкость часы	108

5. Содержание дисциплины (модуля)

5.1. Содержание разделов и тем дисциплины (модуля). Все разделы и темы нумеруются.

- **Введение.**
- **Р 1. Системный подход к процессам микро- и нанотехнологии**
- Системная модель технологического процесса: объект, воздействие, процесс. Классификация процессов микро- и нанотехнологии по физико-химической сущности: механический, термический, химический, корпускулярно-полевой; виду процесса: нанесение, удаление, модифицирование; характеру протекания процессов: тотальный, локальный, селективный, избирательный, анизотропный; способу активации: тепло, излучение, поле. Виды термического и корпускулярно-лучевого воздействий: резистивный, лучистый и индукционный нагрев, электронные и лазерные пучки, плазма и ионные пучки. Каталитические свойства поверхности и атомно-силовое воздействие.
- **Р.2. Производственная чистота, гигиена и безопасность.** Возникновение и развитие микро- и нанотехнологии. История появления материаловедческо-технологического базиса и основных организационных принципов.
- Чистые помещения: классификация производственных помещений по чистоте воздушной среды и микроклимату, источники загрязнений, способы обеспечения и поддержания чистоты. Вакуум: глубина вакуума, средства откачки и методы контроля. Технологические среды: чистота материалов, воды, газовых сред и жидкостей. Аппаратура и элементы газовых и жидкостных систем. Базовые операции очистки жидких и газообразных сред. Очистка поверхности пластин. Безопасность работы в чистых помещениях: токсичные, взрывоопасные и пожароопасные среды. Утилизация отходов.
- **Р.3. Оборудование и методы осаждения вещества.**

Оборудование и методы нанесения вещества в вакууме из молекулярных пучков: вакуум-термическое и электронно-лучевое испарение, молекулярно-лучевая эпитаксия. Оборудование и методы ионно-плазменного осаждения: катодное, магнетронное, реактивное распыления; ионно- и плазмохимическое осаждение. Оборудование и методы осаждения из газовой фазы: получение поликристаллического и аморфного гидрогенизированного кремния, оксида и нитрида кремния; пиролитическое осаждение металлов; газофазная эпитаксия кремния, бинарных и многокомпонентных соединений; газофазные методы молекулярной химической сборки. Оборудование и методы осаждения из жидкой фазы: жидкофазная эпитаксия, электрохимическое осаждение слоев, нанесение моно- и мультислоев органических веществ методом Ленмюра-Блоджетт. Золь-гель технология.

■ **Р.4. Оборудование и методы удаления вещества.**

Шлифование и полирование пластин. Электрохимическая, ультразвуковая и электроэрозионная обработки. Механическое, лазерное и электронно-лучевое скрайбирование. Вакуум-термическое травление. Процессы химического травления: механизмы травления; оборудование, методы и среды для жидкостного и газового травления; локальное и анизотропное ориентационно-чувствительное травление; маскирующие, «жертвенные» и «стоп»-слои. Электрохимическое травление, получение пористого кремния. Ионно-плазменное травление: оборудование, методы и механизмы травления; ионно-лучевое, плазмохимическое, реактивное ионно-плазменное, ионно-химическое травление.

■ **Р.5. Оборудование и методы модифицирования вещества.**

Оборудование и методы окисления в газовой и жидких средах: высокотемпературное термическое сухое и влажное окисление, электрохимическое окисление, теоретические модели окисления. Окисление и нитрирование в плазме. Диффузия примесей: распределение примесей при диффузии, стадии загонки и разгонки примесей, оборудование и методы диффузии из газообразных, жидких и твердых источников. Ионная имплантация: распределение примесей, оборудование и методы ионной имплантации. Высокоэнергетические сильноточные процессы ионной имплантации: окисление, нитрирование, протонирование, радиационно-стимулированная диффузия, химический синтез. Имплантография: жидкометаллические источники ионов, ионно-полевая эмиссия. Низкоэнергетическая ионная имплантация методом погружения в плазму. Активация процессов при ионном легировании и химическом синтезе: термический и корпускулярно-лучевой отжиг.

■ **Р.6. Литографические процессы.**

Классификация базовых методов литографии: фото-, рентгено-, электроно- и ионолитография. Литографический цикл: резисты и способы их нанесения, позитивные, негативные, жидкие и сухие резисты; методы повышения адгезии, плазмостойкости; планаризация, предэкспозиционная обработка, проявление и сушка. Фотошаблоны. Аппаратура и способы совмещения и экспонирования. Пространственное разрешение. Эволюция процессов экспонирования: высокоэффективные источники дальнего ультрафиолета, оптическая литография с фазовым сдвигом, стереолитография, электроно-, ионо-, рентгенолитография. Литография с использованием синхротронного излучения. Объемная субмикронная литография.

■ **Р.7. Литографические процессы.**

Сборка микроэлектронных устройств: монтаж кристаллов, термокомпрессия, ультразвуковая микросварка, пайка выводов; оборудование для микросборки; беспроводный монтаж. Герметизация микроэлектронных устройств: корпусная и бескорпусная герметизации. Сварка: контактная, под давлением, лазерная, электронно-лучевая. Герметизация: пайка, обволакивание, заливка, прессование.

■ **Р.8. Интенсификация и интеграция процессов микро- и нанотехнологии.**

Физико-технологические и экономические ограничения миниатюризации и интеграции. Нетермические методы активации физико-химических процессов: локальность, избирательность, скорость протекания процессов. Активация процессов полем и излучением: электрически стимулированная эпитаксия; фото- и СВЧ-стимулированные процессы осаждения, окисления и травления. Туннельно-полевое модифицирование поверхности: квантово-механические принципы локального переноса заряда, энергии, массы; технология атомно-молекулярного массопереноса и модифицирования с наноразрешением. Базовые принципы интеграции процессов: аппаратная и топохимическая интеграция. Самоформирование: интеграция физико-химических процессов на основе топохимической селективности поверхности, структурно-топологические операции на основе анизотропии, маски дифференциального действия, принцип матрицы. Интегрированные технологические кластерные комплексы: минифабрики, нанотехнологические комплексы на основе туннельно-полевого массопереноса и модифицирования. Системный подход к управлению качеством продукции: ЕСТД и её применение, структура и функции АСУТП, оптимизация контрольно-измерительных операций.

■ **Заключение.**

Построение технологических процессов на основе оптимального сочетания принципов управления, самоформирования, самоорганизации: адаптивный синтез микроэлектронных структур, самосогласованные цепи технологических операций. Атомно-молекулярная инженерия

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами

№ п/п	Наименование обеспечиваемых (последующих) дисциплин	№ № разделов и тем данной дисциплины, необходимых для изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин (вписываются разработчиком)								
1.	Материалы и элементы электронной техники	3	4	5						
2.	Микроэлектроника	6	7							
...										

5.3. Разделы и темы дисциплин (модулей) и виды занятий

№ п/п	Наименование раздела	Наименование темы	Виды занятий в часах					
			Лекц.	Практ. зан.	Семина	ксп.	СРС	Всего
1.	Системный подход к процессам микро- и нанотехнологии	Системная модель технологического процесса: объект, воздействие, процесс. Виды термического и корпускулярно-лучевого воздействий: резистивный, лучистый и индукционный нагрев, электронные и лазерные пучки, плазма и ионные пучки. Каталитические	4.	4.		1	8	17

		свойства поверхности и атомно-силовое воздействие						
2.	Производственная чистота, гигиена и безопасность	Классификация производственных помещений по чистоте воздушной среды и микроклимату, источники загрязнений, способы обеспечения и поддержания чистоты Технологические среды Безопасность работы в чистых помещениях: токсичные, взрывоопасные и пожароопасные среды	4.	4.		2	8	18.
3.	Оборудование и методы осаждения вещества	Оборудование и методы нанесения вещества в вакууме из молекулярных пучков: вакуум-термическое и электронно-лучевое испарение, молекулярно-лучевая эпитаксия. Оборудование и методы ионно-плазменного осаждения: катодное, магнетронное, реактивное распыления; ионно- и плазмохимическое осаждение. Оборудование и методы осаждения из газовой фазы: Оборудование и методы осаждения из жидкой фазы: жидкофазная эпитаксия	4.	4.		2	8.	18
4	Оборудование и методы удаления вещества.	Шлифование и полирование пластин Травление	4.	4.		1	8	17
5	Оборудование	Методы окисления в	6	6		1	8	21

	и методы модифицирования	газовой и жидких сред Диффузия примесей:						
6	Литографические процессы	Базовые методы литографии	6.	6.		1	8	21
7	Сборка и герметизация	Сборка микроэлектронных устройств: . Герметизация микроэлектронных устройств:	4.	4.		1	7.	16.
8	Интенсификация и интеграция процессов микро- и нанотехнологии	. Физико-технологические и экономические ограничения миниатюризации и интеграции Базовые принципы интеграции процессов: аппаратурная и топохимическая интеграция	4.	4.		1	7.	16.
		всего	36	36		10	62	144

6. Перечень семинарских, практических занятий и лабораторных работ

№ п/п	№ раздела и темы дисциплины (модуля)	Наименование семинаров, практических и лабораторных работ	Трудоемкость (часы)	Оценочные средства	Формируемые компетенции
1	2	3	4	5	6
1	Системный подход к процессам микро- и нанотехнологии	Системная модель технологического процесса: объект, воздействие, процесс	2	Письменный текущий контроль	ПК-8
2	Системный подход к процессам микро- и нанотехнологии	Каталитические свойства поверхности и атомно-силовое воздействие	2	Письменный текущий контроль	ПК-8
3	Производственная чистота, гигиена и безопасность	Классификация производственных помещений по чистоте воздушной среды и микроклимату, источники загрязнений,	2	Письменный текущий контроль	ПК-8
4	Производ-	способы обеспечения и	2	Письменный	ПК-8

	ственная чистота, гигиена и безопасность	поддержания чистоты		текущий контроль	
5	Оборудова- ние и методы модифици- рования	Оборудование и методы нанесения вещества в вакууме из молекулярных пучков:	2	Письменный текущий контроль	ПК-8
6.	Оборудова- ние и методы модифици- рования	: Вакуум-термическое и электронно-лучевое испарение, Оборудование и методы осаждения из газовой фазы, жидкофазная эпитаксия	2	Письменный текущий контроль	ПК-8
7.	Оборудова- ние и методы модифици- рования	Шлифование и полирование пластин	2	Письменный текущий контроль	ПК-8
...8	Оборудова- ние и методы модифици- рования	Травление	2	Письменный текущий контроль	ПК-8
9	Оборудова- ние и методы модифици- рования	Методы окисления в газовой сред	2	Письменный текущий контроль	ПК-8
10	Оборудова- ние и методы модифици- рования вещества.	Диффузия примесей:	2	Письменный текущий контроль	ПК-8
11	Оборудова- ние и методы модифици- рования	Методы окисления в жидких сред	2	Письменный текущий контроль	ПК-8
12	Литографи- ческие процессы	Базовые методы литографии	2	Письменный текущий контроль	ПК-8 -
13	Литографи- ческие процессы	Базовые методы литографии	2	Письменный текущий контроль	ПК-8 -
114	Литографи- ческие процессы	Базовые методы литографии	2	Письменный текущий контроль	ПК-8 -
115	Сборка и	Сборка микросистемных	2	Письменный	ПК-8

	герметизация	устройств		текущий контроль	-
116	Сборка и герметизация	. Герметизация микроэлектронных устройств	2	Письменный текущий контроль	ПК-8 -
17	Интенсификация и интеграция процессов микро- и нанотехнологии	. Физико-технологические и экономические ограничения миниатюризации и интеграции	2	Письменный текущий контроль	ПК-8 -
18	Интенсификация и интеграция процессов микро- и нанотехнологии	Базовые принципы интеграции процессов: аппаратурная и топохимическая интеграция	2		

6.1. План самостоятельной работы студентов

№ нед.	Тема	Вид самостоятельной работы	Задание	Рекомендуемая литература	Количество часов
1	T1.	Работа с учебником, справочной литературой, первоисточниками, конспектом	Повторение и углубленное изучение учебного материала лекции, ПЗ с использованием конспекта лекций, литературы, Интернет - ресурсов	Источники 1,2 из основной и 1.2 из дополнительной литературы; Самостоятельный поиск литературы на образовательных ресурсах, доступные по логину и паролю, предоставляемым Научной библиотекой ИГУ	8
3	T2.				8
5	T3.				8
7	T4.				8
9	T5.				8
11	T6				8
13	T7				7
— _18 —	T8				----- -7-

6.2. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов

Самостоятельная работа студентов – индивидуальная учебная деятельность, осуществляемая без непосредственного руководства преподавателя (научного руководителя (консультанта)), в ходе которой студент активно воспринимает, осмысливает полученную информацию, решает теоретические и практические задачи. В процессе проведения самостоятельной работы формируются компетенции ПК-8 .

На самостоятельную работу выносятся следующие вопросы по темам дисциплины

1. Системный подход к процессам микро- и нанотехнологии 8 ч.
2. . Производственная чистота, гигиена и безопасность. 8ч.
- 3 Производственная чистота, гигиена и безопасность 8ч.
- 4 Оборудование и методы осаждения вещества 8.ч
- 5 Оборудование и методы удаления вещества 8.ч.
- 6 Оборудование и методы модифицирования 8ч.
7. Литографические процессы 8.ч
8. Сборка и герметизация 7ч.

9. Интенсификация и интеграция процессов микро- и нанотехнологий^{7.ч.}

Контроль самостоятельной работы проводится на практических занятиях и на КСР по окончании Т.9.

7. Примерная тематика курсовых работ (проектов) (при наличии) планом не предусмотрено

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля):

а) основная литература _

1. Технологии материалов для микро- и нанoeлектроники : учеб. пособие / Л. А. Скоробогатова [и др.] ; Иркутский гос. ун-т. - Иркутск : Изд-во ИГУ, 2009. - 83 с. : ил. ; 20 см. - Библиогр.: с. 83. (13 экз).

2. Технологии материалов для микро- и нанoeлектроники [Электронный ресурс] : учеб. пособие. - ЭВК. - Иркутск : Изд-во ИГУ, 2009. - Режим доступа: ЭЧЗ "Библиотех". - Неогранич. Доступ

б).дополнительная литература:

1. Пул, Ч. П. Нанотехнологии [Текст] : учеб. пособие для студ., обуч. по напр. подготовки "Нанотехнологии" / Ч. П. Пул, Ф. Оуэнс. - М. : Техносфера, 2004. - 327 с. : рис., граф. ; 24 см. - (Мир материалов и технологий). - Библиогр. в конце глав. - Пер. изд. : Introduction to Nanotechnology / Charles P. Poole, Frank J. Owens. - 2003. - ISBN 5-94836-021-0 (3 экз.)

2. Нашельский, Александр Яковлевич. Технология полупроводниковых материалов : учеб. пособие / А. Я. Нашельский. - М. : Металлургия, 1972. - 432 с. : ил. ; 22 см. - Библиогр.: с. 427-429. (2 экз.)

3. Таиров, Юрий Михайлович.

Технология полупроводниковых и диэлектрических материалов [Текст] : учеб. для вузов / Ю.М. Таиров. - 3-е изд., стер. - СПб. : Лань, 2002. - 423 с. : ил ; 21 см. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - Библиогр.: с. 418. -Предм. указ.: с. 419-421. - ISBN 5-8114-0438-7(11 экз).

в) программное обеспечение _

www.nanonewsnet.ru – Сайт о нанотехнологиях в России.

www.nanodigest.ru – Интернет журнал о нанотехнологиях

www.nano-info.ru - Сайт о современных достижениях в области микро- и нанотехнологий

www.nanometer.ru – Сайт нанотехнологического сообщества ученых, студентов и любознательных читателей

www.nano-portal.ru - Портал посвящен теме развития нанотехнологий и их внедрения в производство

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля):

Чтение лекций сопровождается демонстрацией информации (мультимедийный проектор, офисное оборудование для оперативного размножения иллюстративного и раздаточного лекционного материалов).

10. Образовательные технологии:

На лекциях используются активные методы обучения (компьютерных симуляций, разбор конкретных ситуаций).

11. Оценочные средства (ОС):

11.1. Оценочные средства для входного контроля

Не предусмотрено.

а. Оценочные средства текущего контроля

Текущий контроль реализуется в виде письменного текущего контроля на Пз1-Пз9- Текущий контроль направлен на выявление сформированности компетенций ПК-8, ПК-9.

Для реализации текущего контроля используется балльно-рейтинговая система оценки, принятая в университете.

Усвоение студентом изучаемой дисциплины максимально оценивается 100 баллами. Максимальное количество предусмотрено 30 баллов. Возможны «премиальные» баллы (от 0 до 10), которые могут быть добавлены студенту за активные формы работы, высокое качество выполненных практических работ, представление оригинального доклада (10 баллов) и т.д.

Параметры оценочного средства для письменного текущего контроля на Пз1-Пз9 и КСР.

Критерии оценки	Оценка / баллы			
	Отлично 5 баллов.	Хорошо 4 балла	Удовлетв. 3 балла.	Неудовл. ➤ 0 балла
Выполнение заданий	Полностью и корректно выполнены все задания. Допущено не более 1 –ой неточности	Полностью выполнены все задания, допущены две малозначительные неточности.	Не полностью выполнены задания, допущены одна – две серьезные ошибки.	Задание не выполнены или задание выполнено не полностью и допущено более 3-х серьезных ошибок.

Примерные вопросы для письменного текущего контроля приведены ниже:

Пз.1

- 1.Какова системная модель технологического процесса
- 2.Охарактеризуйте.виды термического и корпускулярно-лучевого воздействий: Каталитические свойства поверхности и атомно-силовое воздействие

Пз.2,Пз3.

- 11.Назовите потенциальные источники загрязнений ИС?
- 2.Какие параметры контролируются в чистых помещениях.?
- 3.Почему статическое электричество является одним из главных параметров, контролируемых при производстве ИС.
- Пз.4,Пз5,Пз6.
- Опишите получение поликристаллического аморфного кремния.
- Опишите получение оксида и нитрида кремния.
- Опишите процесс получения тонких слоёв металлов методом газофазной Что называется эпитаксией?
- Какой процесс называется газофазной эпитаксией?
- Какие реагенты используются для получения Si из парогазовой смеси? Запишите реакцию восстановления Si из тетрахлорида кремния и из силана.
- Опишите хлоридный процесс получения кремния.
- Как очищается подложка перед эпитаксией?
- Каковы преимущества метода эпитаксиального наращивания?
- Опишите эпитаксии. Для чего они используются в ИС

Пз.7,Пз-8

- 1. Как выполняется лазерное скрайбирование?
- 2. Каковы разновидности травления?

- 3. Какие травители применяют для селективного травления поверхности полупроводниковых пластин.
- 4. По каким признакам разделяют процессы ионно-плазменного и ионно - лучевого травления?
- Каков механизм фотостимулированного травления?
- Какие смеси используют при селективном травлении кремния, арсенида галлия.
- Пз.9,Пз10,Пз11.
- 1.Какие методы легирования полупроводников вы знаете?
- 2.Какие механизмы диффузии вы знаете?
- 3.Какие вещества используют в качестве источников примеси при легировании фосфором?
- 4.При какой температуре проводят вторую стадию диффузии и какую роль эта стадия играет?
- 5.Какие способы диффузии вы знаете?
- 6. В чем различие методов ионной имплантации и термодиффузии.
- 7. Зачем проводится импульсный отжиг?
- Пз.12,Пз13,Пз14.
- 1. Каковы особенности различных методов литографии?
- 2. Какие операции и в какой последовательности выполняются при фотолитографии?
- 3. Какой процесс называется литографией, на чём он основан?
- 4. Что такое фотошаблон
- Пз15,Пз16,Пз17Пз18.
- 1.Перечислите основные процессы сборки ИС. Охарактеризуйте каждый из них.
- 2.Что такое термокомпрессия?
- 3 Каков принцип ультразвуковой сварки? Микроконтактной сварки?
- 4.Какими свойствами должен обладать инструмент для присоединения контактов?
- 5.Что такое герметизация?
- 6.Что представляет собой корпусная и бескорпусная герметизация?
- 7.Как герметизируют корпуса пайкой? корпуса пайкой?

а. Оценочные средства для промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация направлена на проверку сформированности компетенций ПК-8, ПК-8 и проводится в форме зачета. Форма проведения зачета – устный по билетам. Зачет проводится во время экзаменационных сессий в соответствии с расписанием. Экзаменационный билет состоит из одного теоретического и одного практического вопроса. Вопросы для самостоятельной подготовки студентов к зачету приведены в приложении 1.

Студент допускается к зачету в том случае, если в течение семестра за текущую работу набрано 40 баллов и более. В противном случае выставляется 0 сессионных баллов. Во время зачета студент может набрать до 30 баллов. Если на ответ студента оценивается менее чем 10-ю баллами, то экзамен считается не сданным, студенту выставляется 0 баллов, а в ведомость выставляется оценка «не зачтено».

Если на зачете студент набирает 10 и более баллов, то они прибавляются к сумме баллов за текущую работу и переводятся в академическую оценку, которая фиксируется в ведомости и зачетной книжке студентов.

Преподаватель выставляет зачет без процедуры его сдачи, если сумма баллов, набранная студентом за текущую работу составит не менее 60 баллов.

Итоговый семестровый рейтинг	Академическая оценка
Не менее 60-баллов	«зачтено »
Менее 60 баллов	«не зачтено »

Критерии	ЗАЧТЕНО			НЕЗАЧТЕНО
Знание	Всесторонние глубокие знания (10 -11 баллов)	Знание материала в пределах программы (7 -9 баллов)	Отмечены пробелы в усвоении программного материала (4 -6 баллов)	Не знает основное содержание дисциплины (0-3 балла)
Понимание	Полное понимание материала, приводит примеры, дополнительные вопросы не требуются (8 -10 баллов)	Понимает материал, приводит примеры, но испытывает затруднения с выводами, однако достаточно полно отвечает на дополнительные вопросы (6 -8 баллов)	Суждения поверхностны, содержат ошибки, примеры не приводит, ответы на дополнительные вопросы неуверенные (4 -6 баллов)	С трудом формулирует свои мысли, не приводит примеры, не дает ответа на дополнительные вопросы (0-3 балла)
Применение проф. терминологии	Дает емкие определения основных понятий, корректно использует профессиональную терминологию (3-5 баллов)	Допускает неточности в определении понятий, не в полном объеме использует профессиональную терминологию (2-3 балла)	Путает понятия, редко использует профессиональную терминологию (1-2 балла)	Затрудняется в определении основных понятий дисциплины, некорректно использует профессиональную терминологию (0-2 балла)
Соблюдение норм литературного языка	Соблюдает нормы литературного языка, преобладает научный стиль изложения (3-4 балла)	Соблюдает нормы литературного языка, допускает единичные ошибки (2- 3 балла)	Допускает множественные речевые ошибки при изложении материала (1-2 балла)	Косноязычная речь искажает смысл ответа (0-1 балл)

Приложение 1

Примерный перечень вопросов и заданий к зачету

Вариант 1

1. Какова роль процессов адсорбции, растворения и диффузии в газопоглощении материалов.

2. Какова физическая сущность методов соединения материалов в жидкой и твердой фазах при формировании герметичных и вакуумно-плотных слоёв.

Вариант 2.

1. Что является движущей силой процесса кристаллизации при физическом и химическом методах осаждения вещества.

2.Опишите процесс удаления поверхностных загрязнений нейтральными моющими жидкостями и роль поверхностно-активных веществ и ультразвука в очистке поверхности.

Вариант 3.

1.Сформулируйте диффузионные законы Фика и граничные условия для задач диффузии.

2. В чём выражается маскирующая функция двуокиси кремния в планарной кремниевой технологии и как вводится маскирующая толщина слоя двуокиси кремния?

Вариант 4.

1.Опишите принципы выращивания монокристаллических слоёв методами жидкофазной и газофазной эпитаксии.

2.Какая из областей процесса травления обеспечивает режим полирующего травления и режим селективного анизотропного травления

Программа составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по направлению подготовки 11.03.04 Электроника и микроэлектроника. «Электроника и микроэлектроника».

Разработчик:



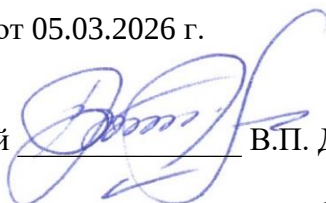
доцент

Петров А.Л.

Программа рассмотрена на заседании кафедры общей и экспериментальной физики

Протокол № 7 от 05.03.2026 г.

И.о. зав. кафедрой



В.П. Дресвянский

Настоящая программа, не может быть воспроизведена ни в какой форме без предварительного письменного разрешения кафедры-разработчика программы.